








	<p>SI1022R-T1-GE3</p>
	<p>Référence fabricant: SI1022R-T1-GE3</p> <p>Fabricant / Marque: Vishay / Siliconix</p> <p>Une partie de la description: MOSFET N-CH 60V 330MA SC-75A</p> <p>Feuilles de données:  SI1022R-T1-GE3.pdf</p> <p>Statut RoHS: Sans plomb / conforme à la directive RoHS</p> <p>État du stock: New original, 54367 pcs Stock Available.</p> <p>Bateau de: Hong Kong</p> <p>Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Caractéristiques

Numéro d'article	SI1022R-T1-GE3
Fabricant	Vishay / Siliconix
La description	MOSFET N-CH 60V 330MA SC-75A
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors -
État de la pièce	54367 pcs Stock
Séries	TrenchFET®
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Package / Boîte	SC-75A
Package composant fournisseur	SC-75A
Dissipation de puissance (max)	250mW (Ta)
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	60V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	330mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.25 Ohm @ 500mA, 10V
Vgs (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	0.6nC @ 4.5V
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	30pF @ 25V
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds	4.5V..10V
Vgs (Max)	±20V
Emballage	Tape & Reel (TR)

SI1022R-T1-GE3 est un nouvel original en stock, recherchez des fiches techniques SI1022R-T1-GE3, PDF, inventaire chez Y-IC.com en ligne, commandez SI1022R-T1-GE3 Vishay / Siliconix avec garantie et confiance. RFQ SI1022R-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Vous pourriez aussi être intéressé par:

 SI1022R-T1-E3 VISHAY SI1022R-T1-E3 VISHAY	 SI1022R VISHAY SI1022R VISHAY	 SI1022R-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 330MA SC-75A	 SI1022R-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 330MA SC-75A
 SI1023-A-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA	 SI1023-A-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA	 SI1022R-T1 VISHAY SI1022R-T1 VISHAY	 SI1022R-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 330MA SC-75A

Hot Pièces

Plus

SI1013CX-T1-GE3	SI1013R-T1	SI1013R-T1-E3	SI1013R-T1-E3	SI1013R-T1-GE3
SI1013R-T1-GE3	SI1013X-T1	SI1013X-T1-E3	SI1013X-T1-E3	SI1013X-T1-GE3
SI1013X-T1-GE3	SI1016CX-T1-GE3	SI1016CX-T1-GE3	SI1016X-T1-E3	SI1016X-T1-E3
SI1016X-T1-GE3	SI1016X-T1-GE3	SI1016X2-T1-GE3	SI1021R-T1	SI1021R-T1-E3
SI1021R-T1-E3	SI1022R-T1	SI1022R-T1-E3	SI1022R-T1-E3	SI1022R-T1-GE3
SI1022R-T1-E3	SI1023CX-T1-GE3	SI1023CX-T1-GE3	SI1023X-T1	SI1023X-T1-E3
SI1023X-T1-E3	SI1023X-T1-GE3	SI1023X-T1-GE3	SI1024-T1	SI1024X-T1
SI1024X-T1-E3	SI1024X-T1-E3	SI1024X-T1-GE3	SI1024X-T1-GE3	SI1024X-TI-GE3
SI1025X-T1	SI1025X-T1-E3	SI1025X-T1-E3	SI1026X-T1	SI1026X-T1-E3
SI1026X-T1-E3	SI1026X-T1-GE3	SI1026X-T1-GE3	SI1028X-T1-GE3	SI1028X-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

AJOUTER: Unité A5-B5 n ° 509, 5 / F, bâtiment de l'usine de Win Win, 15-17 rue Shing yip, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Droits d'auteur © 2019 YIC International Co., Limited